

# 2SB1018

シリコンPNP三重拡散形(PCT方式)

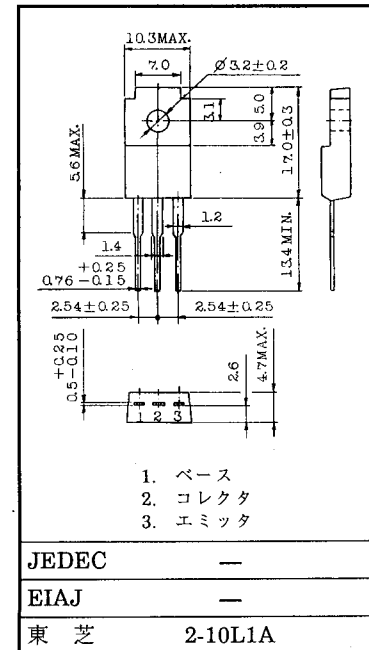
- 大電流スイッチング用
- 電力増幅用

通信工業用  
単位 : mm

- ・ 許容コレクタ電流が大きい。 :  $I_C = -7A$
- ・ コレクタ飽和電圧が低い。  
:  $V_{CE(sat)} = -0.5V$  (最大) ( $I_C = -4A$ )
- ・ 2SD1411とコンプリメンタリになります。

最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項 目	記 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	-100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-7	A
ベース電流	$I_B$	-1	A
コレクタ損失	PC	$T_a = 25^\circ C$	2.0
		$T_c = 25^\circ C$	30
接 合 温 度	$T_j$	150	$^\circ C$
保 存 温 度	$T_{stg}$	-55~150	$^\circ C$



電気的特性 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項 目	記 号	測 定 条 件	最小	標準	最大	単 位
コレクタしゃ断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB} = -100V, I_E = 0$	—	—	-5	$\mu A$
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-5	$\mu A$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V(BR)_{CEO}$	$I_C = -50mA, I_B = 0$	-80	—	—	V
直 流 電 流 増 幅 率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE} = -1V, I_C = -1A$	70	—	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -1V, I_C = -4A$	30	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -4A, I_B = -0.4A$	—	-0.3	-0.5	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -4A, I_B = -0.4A$	—	-0.9	-1.4	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -4V, I_C = -1A$	—	10	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	250	—	pF
ス イ ッ チ ン グ 時 間	ターンオン時間	$t_{on}$	—	0.4	—	$\mu s$
	蓄積時間	$t_{stg}$	—	2.5	—	
	下降時間	$t_f$	—	0.5	—	

注 :  $h_{FE(1)}$  分類 O : 70~140, Y : 120~240

